

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1. Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών
 2. Χαρακτηρισμός Καταλυτών
- 

Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών

Τεχνικές Εμποτισμού

- Ξηρός Εμποτισμός
 - Υγρός Εμποτισμός
- } Απλός Εμποτισμός
- Εναπόθεση - Καθίζηση
 - Ισορροπία Εναπόθεσης-Διήθηση
 - Ετερογενοποίηση ομογενών καταλυτών
 - Εμβολιασμός



Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών με Ξηρό Εμποτισμό

Οξειδικός Καταλύτης

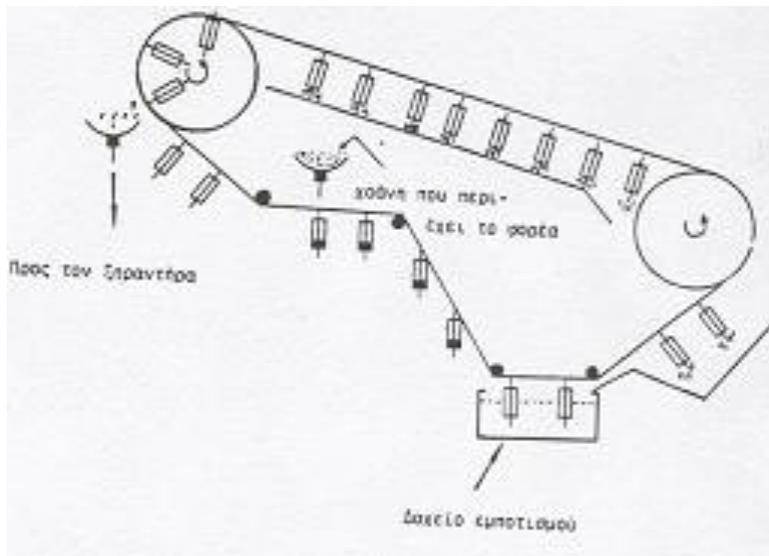
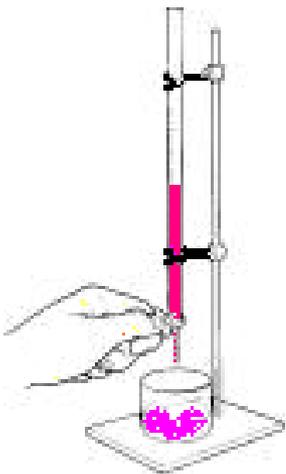
① Εμποτισμός → ② Ξήρανση → ③ Πύρωση στον Αέρα → ④ Ενεργοποίηση

Αναγωγή
Θείωση

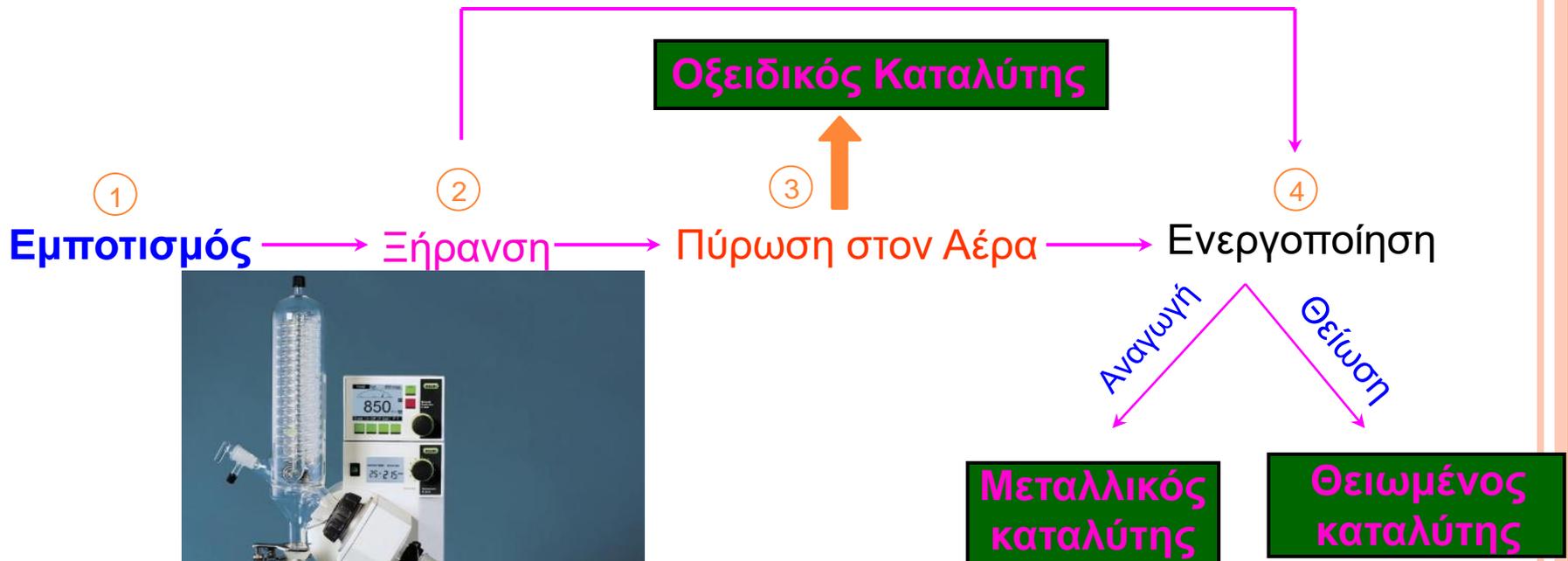
Μεταλλικός
καταλύτης

Θειωμένος
καταλύτης

Ξηρός



Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών με Υγρό Εμποτισμό



Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών με Ισορροπία Εναπόθεσης – Διήθηση (EDF)

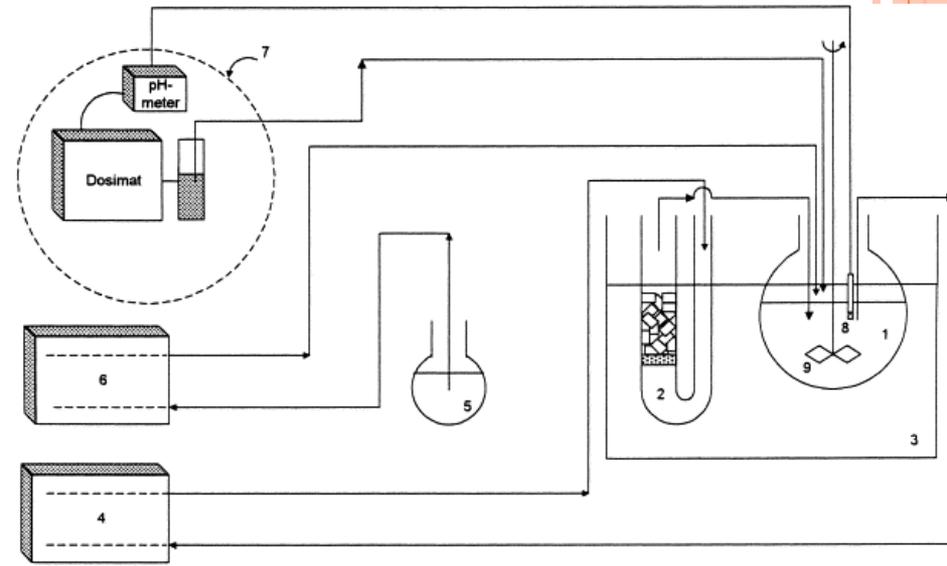
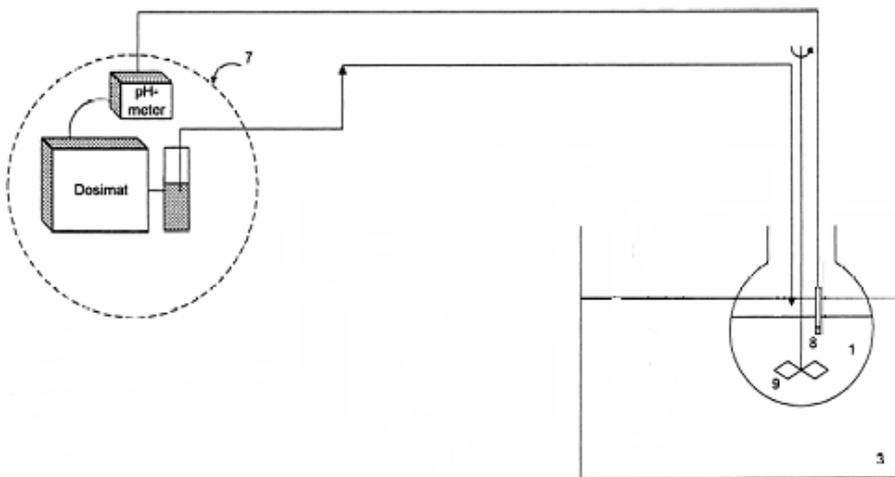
①
Εμποτισμός

②

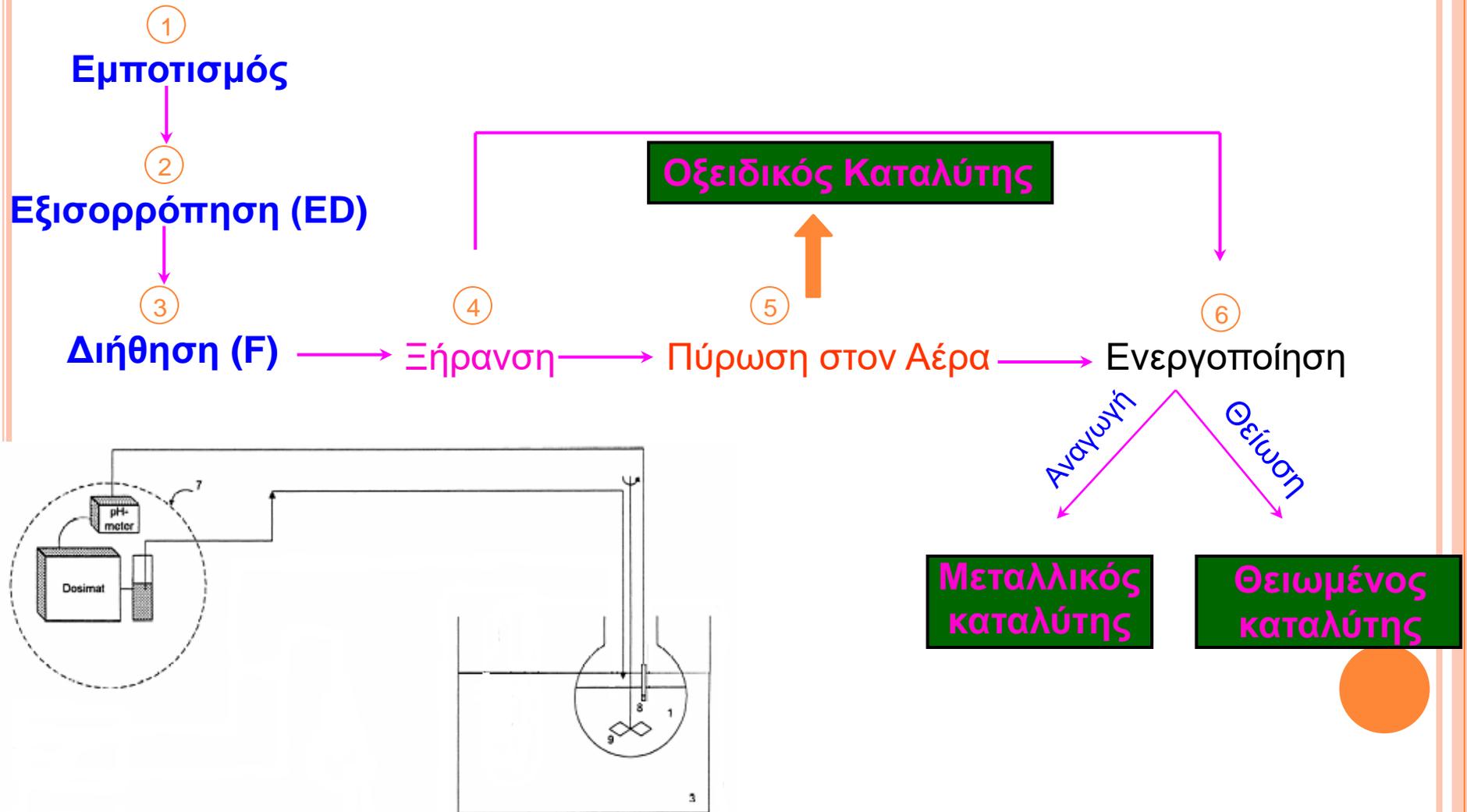
Εξισορρόπηση (ED)

③

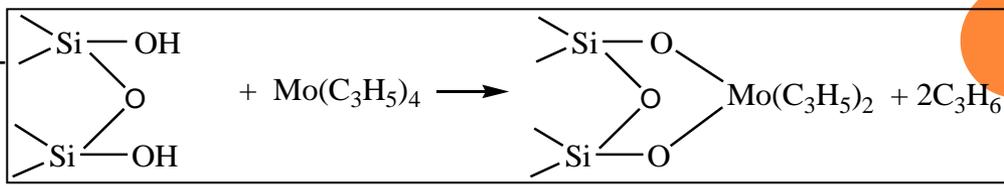
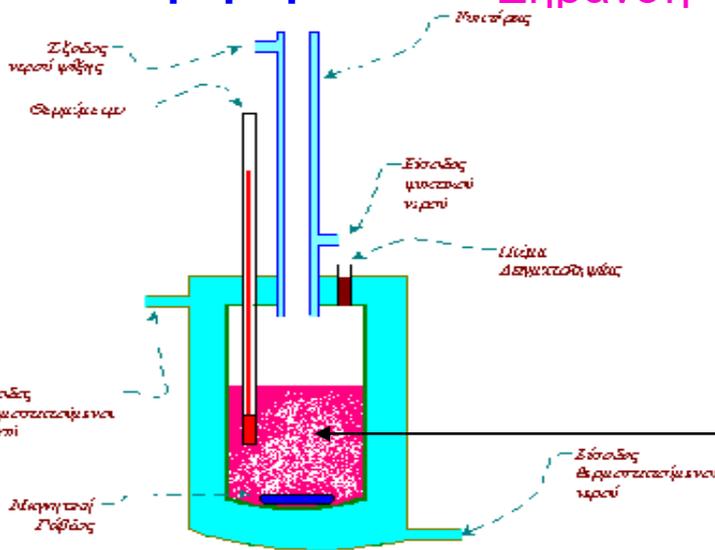
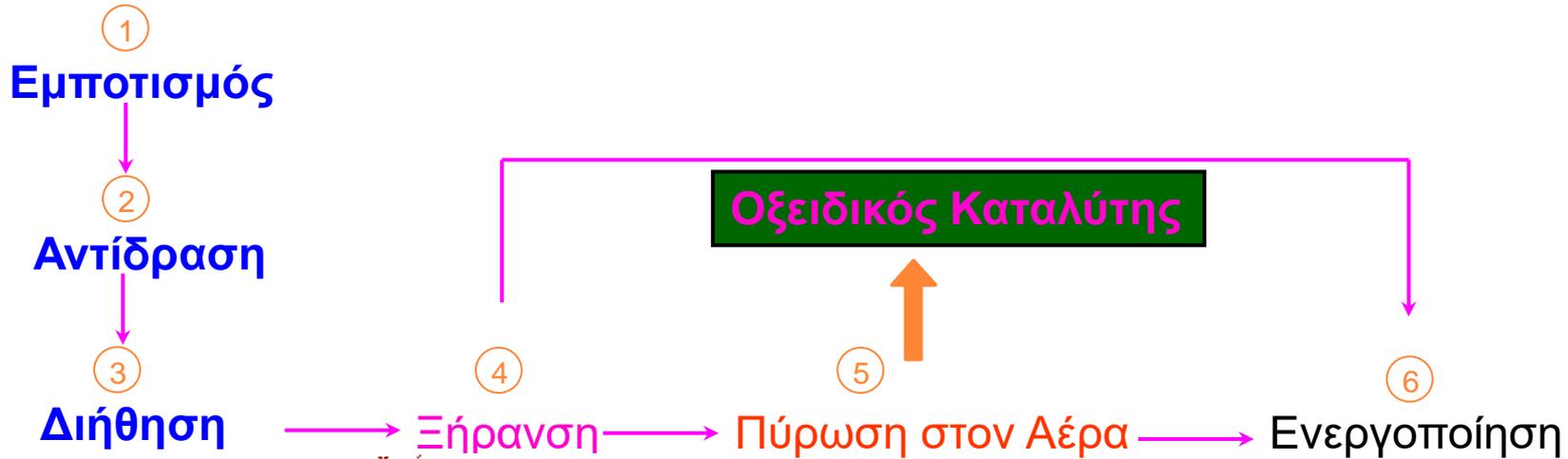
Διήθηση (F)



Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών με Ισορροπία Εναπόθεσης – Διήθηση (EDF)



Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών με Εμβολιασμό

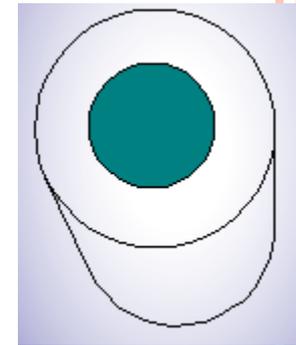
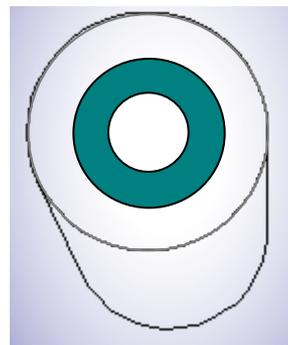
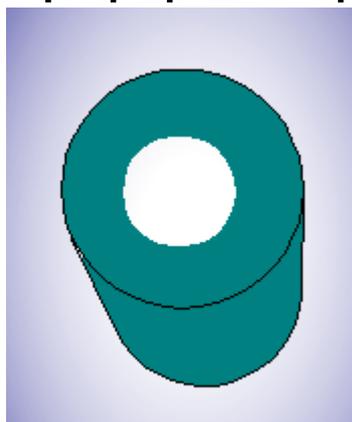
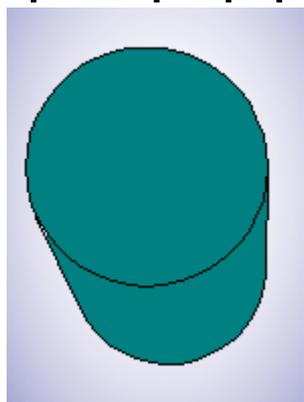


Μεταλλικός καταλύτης

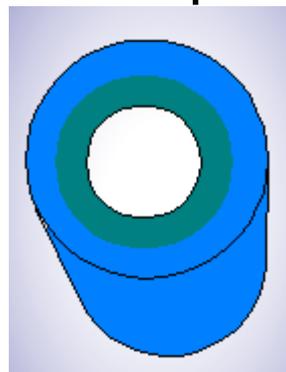
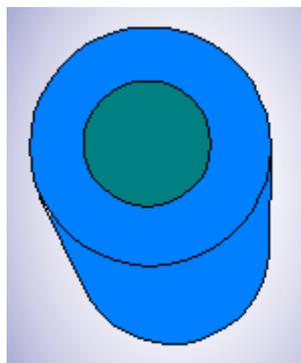
Θειωμένος καταλύτης

Μακροκατανομές στηριγμένης φάσης

Ομοιόμορφη Περιφερειακή Ενδιάμεση περιφερειακή Κεντρική



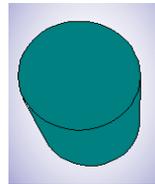
Κατανομές δύο στηριγμένων φάσεων



Παρασκευή Στηριγμένων Καταλυτών με διάφορες μακροκατανομές στηριγμένης φάσης

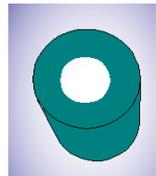
Πως επιτυγχάνονται

Ομοιόμορφη



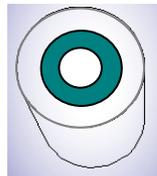
❖ Μεγάλος χρόνος εμποτισμού

Περιφερειακή



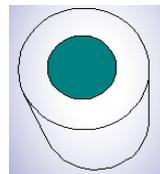
❖ Μικρός χρόνος εμποτισμού
❖ Προεμποτισμός με καθαρό διαλύτη

Ενδιάμεση
περιφερειακή



❖ Χρήση ανταγωνιστών

Κεντρική

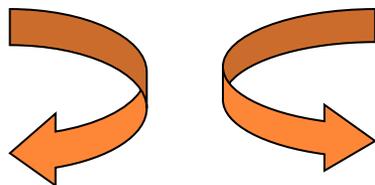


❖ Μεγάλη συγκέντρωση ανταγωνιστή
ή ομοιόμορφη κατανομή και κατόπιν
εκρόφιση δραστικής φάσης από το
εξωτερικό του τεμαχιδίου

Χαρακτηρισμός Καταλυτών

Ποσοτικός προσδιορισμός των **Φυσικών** και **Χημικών** ιδιοτήτων των στερεών καταλυτών που θεωρούνται υπεύθυνες για την καταλυτική τους συμπεριφορά

Έλεγχος παρασκευής



Διευκρίνιση μηχανισμού απενεργοποίησης



Σχεδιασμός και παρασκευή βελτιωμένων καταλυτών



Χαρακτηρισμός Καταλυτών

ex-situ

in-situ

operando

Φυσικές ιδιότητες

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Πάχος επιστρώματος

Αντοχή σε τριβές και πιέσεις

Μέγεθος επιφάνειας

Μέγεθος πόρων & κατανομή

Χημικές ιδιότητες

Σύσταση (επι-)υποστρώματος

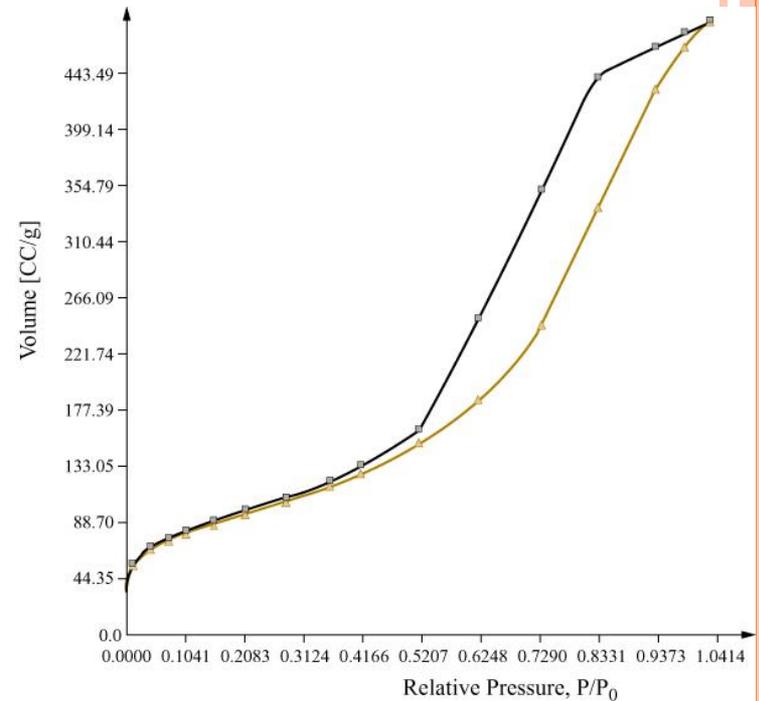
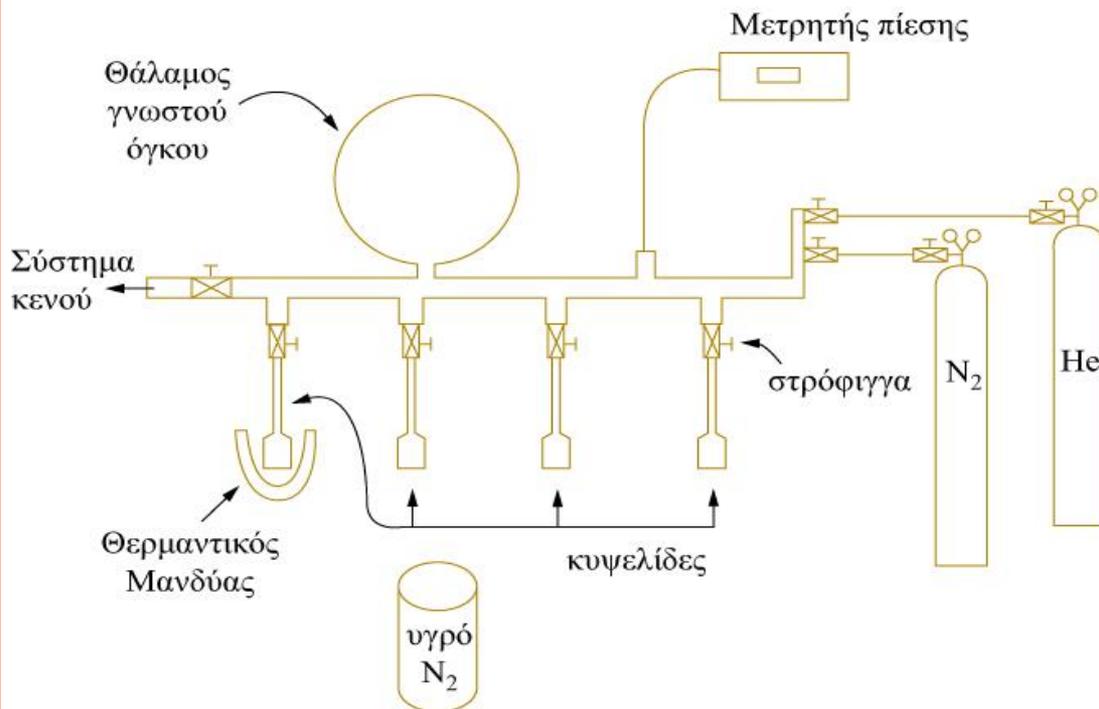
Κρυσταλλική Δομή

Δομή δραστικών ειδών



Μέτρηση επιφάνειας και κατανομής μεγέθους πόρων

- ✓ Ρόφηση-Εκρόφηση N_2 σε θερμοκρασία υγρού N_2



Προσδιορισμός μεγέθους των τεμαχιδίων και των μικροτεμαχιδίων των στερεών καταλυτών

Κοσκίνισμα



Πάχος επιστρώματος

- ✓ Οπτικό μικροσκόπιο

Μηχανική αντοχή μονόλιθου

- ✓ Μέτρηση κατά τον άξονα και την ακτίνα, της δύναμης που απαιτείται για τη θραύση

Ποιότητα πρόσφυσης επιστρώματος

- ✓ Μέτρηση απώλειας βάρους υπό την επίδραση ρεύματος αέρα
- ✓ Η μέτρηση γίνεται με εφαρμογή μεταβλητής θερμοκρασίας



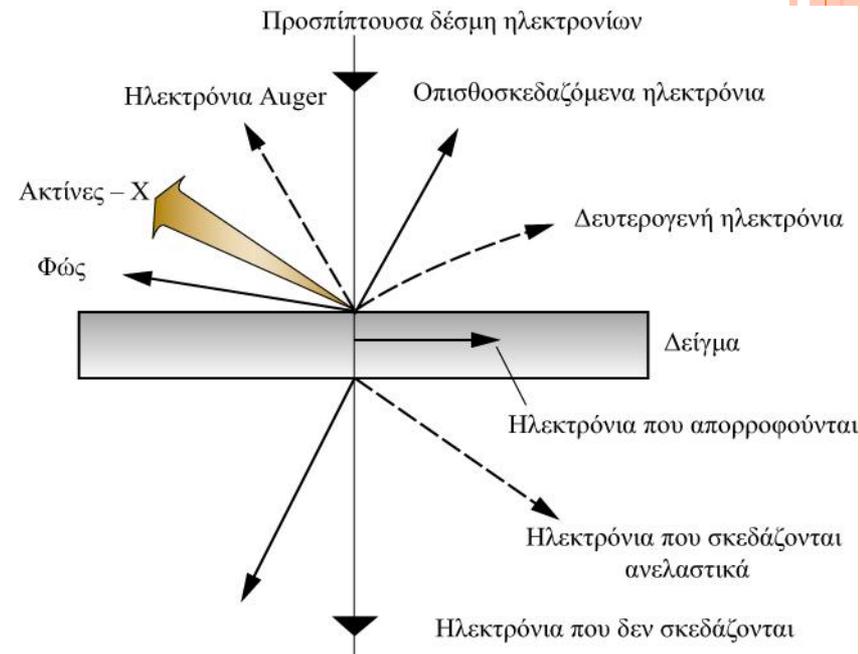
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

✓ Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM):
Καταγραφή ειδώλου επιφάνειας

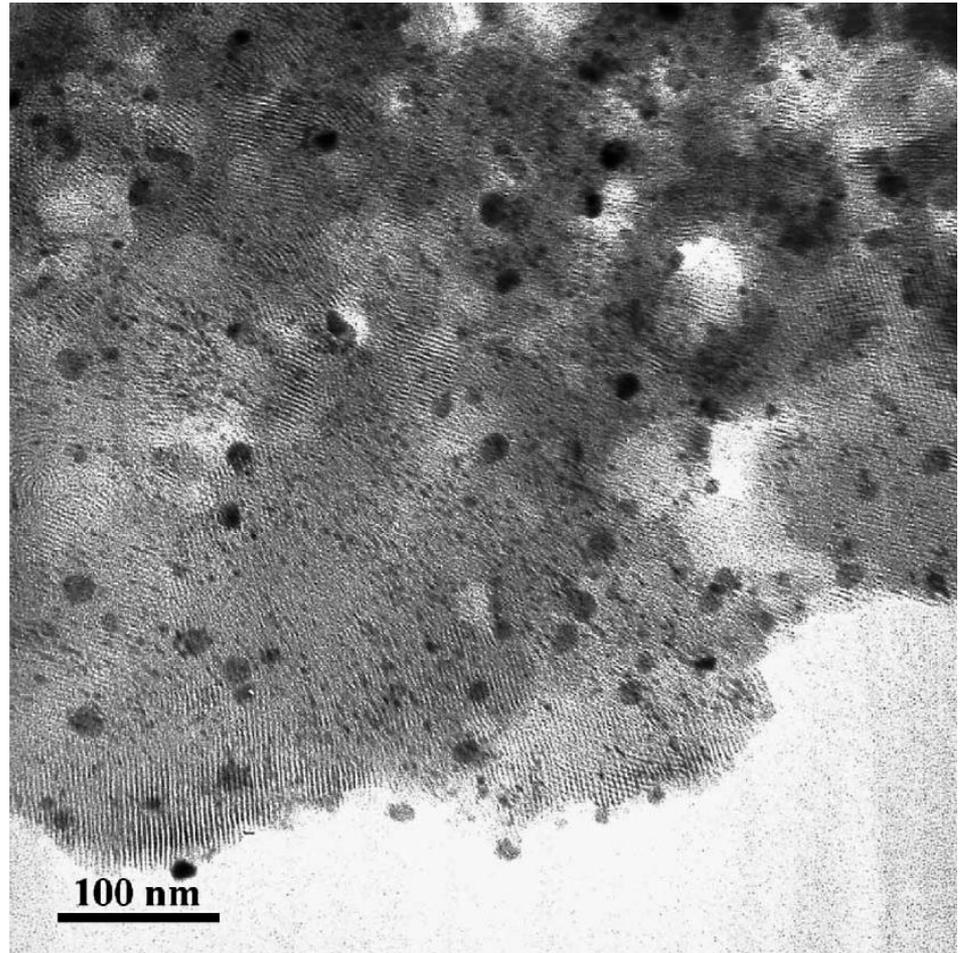
EDX ή WDS: προσδιορισμός σύστασης

✓ Μικροανάλυση (EPMA)
Ποσοτική μελέτη

✓ Ηλεκτρονική μικροσκοπία διαπερατότητας (TEM)



✓ Ηλεκτρονική μικροσκοπία
διαπερατότητας (TEM)

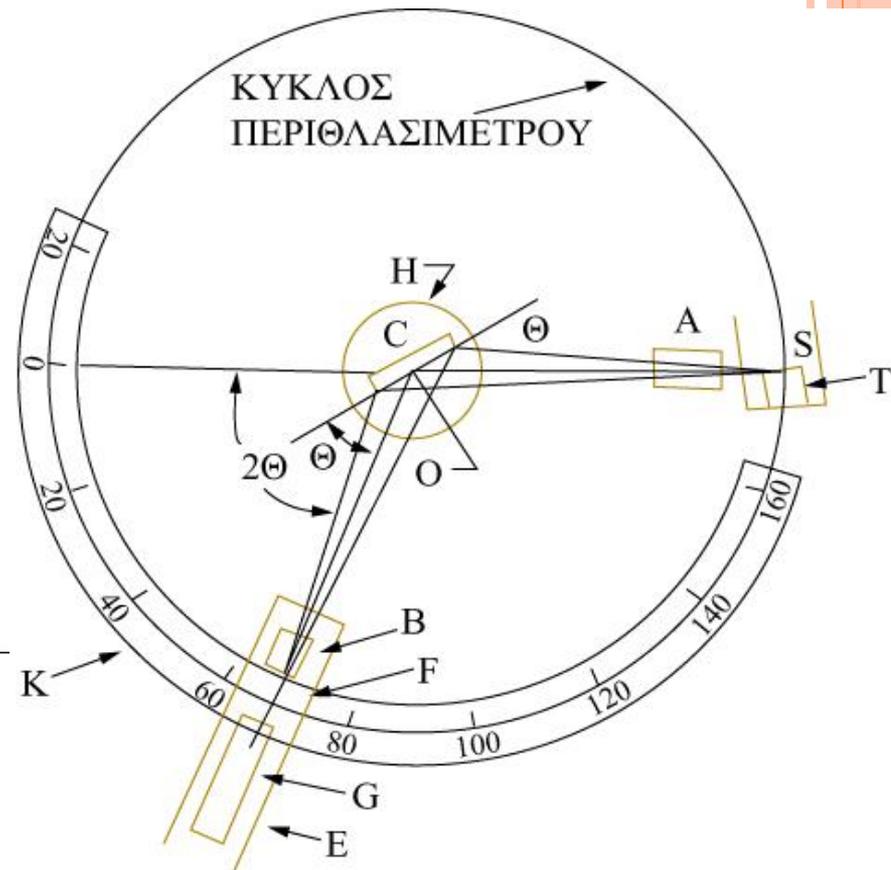
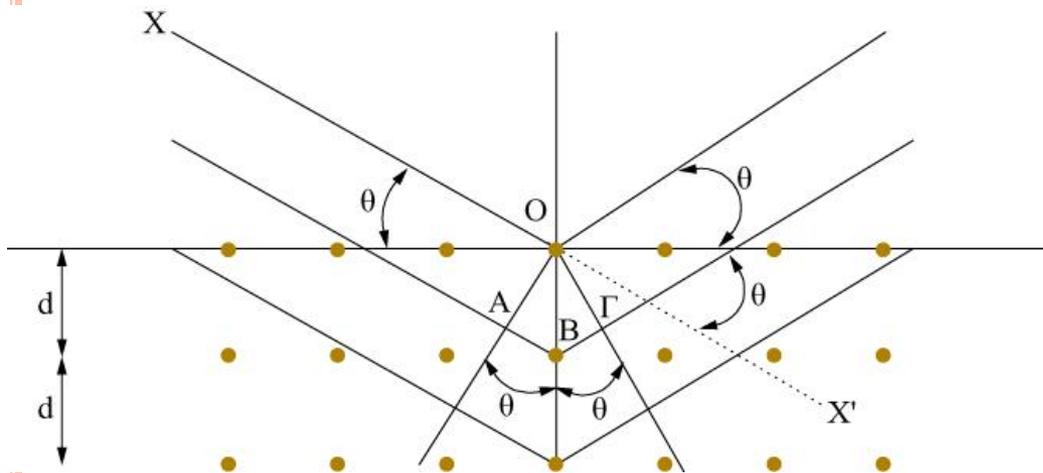


Μέθοδοι προσδιορισμού της κρυσταλλικής δομής των καταλυτικών συστατικών

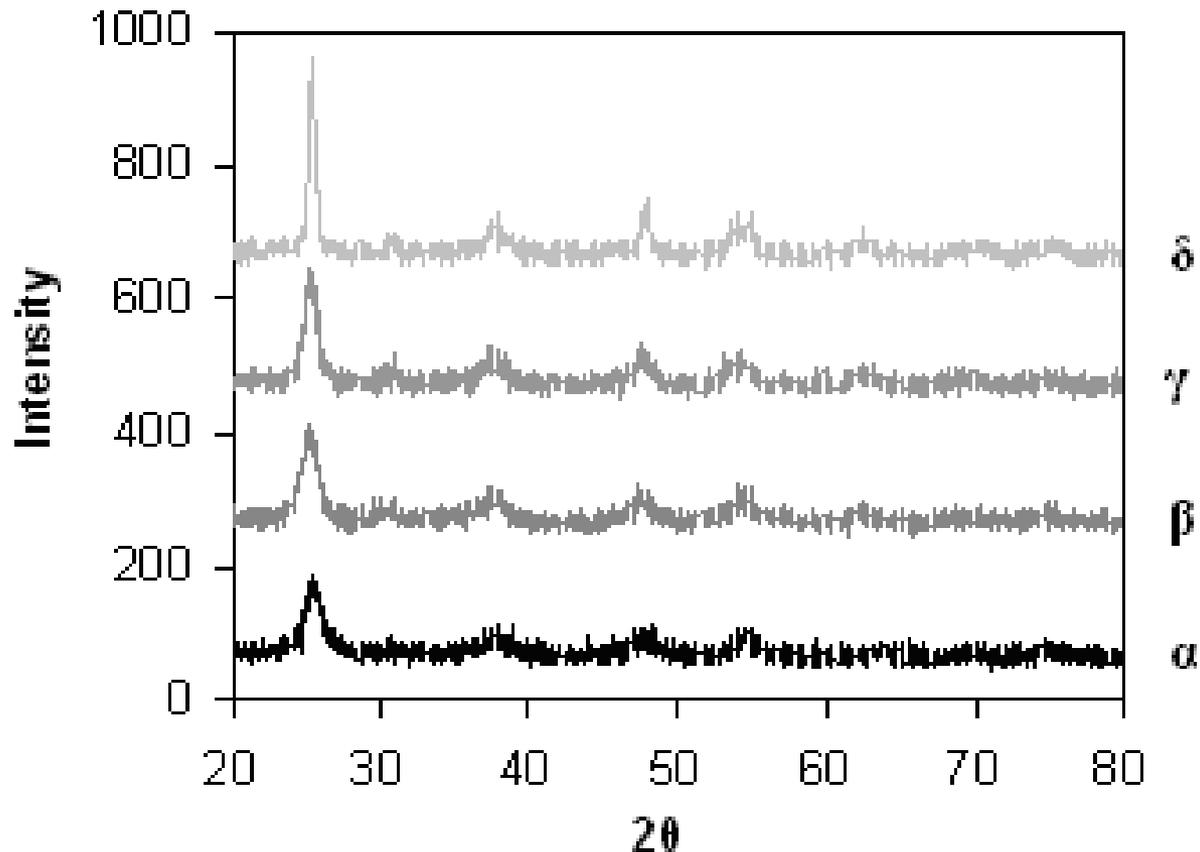
Περίθλαση Ακτίνων – X από σκόνη

σύσταση, μέγεθος και δομή

$$m\lambda = 2d \sin\theta, \quad m = 1, 2, 3, \dots$$



Περίθλαση ακτίνων Χ



Scherrer equation:

$$d = \frac{\kappa \cdot \lambda}{B \cdot \cos \theta}$$

όπου:

δ

$\kappa \approx 1$

λ: (ΚαCu=1.5418Å)

γ

B: (degree · 2π/360 = rad)

θ/degree

β

d/Å

α

Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ οξειδίου του τιτανίου που έχει πυρωθεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες: (α)200°C, (β)300 °C, (γ)400 °C και 500 °C.

Μέθοδοι προσδιορισμού της δομής των καταλυτικών συστατικών

Φασματοσκοπίες Δόνησης

1. Φασματοσκοπία Υπερύθρου (IR και FTIR)

Διαπερατότητα – Απορρόφηση

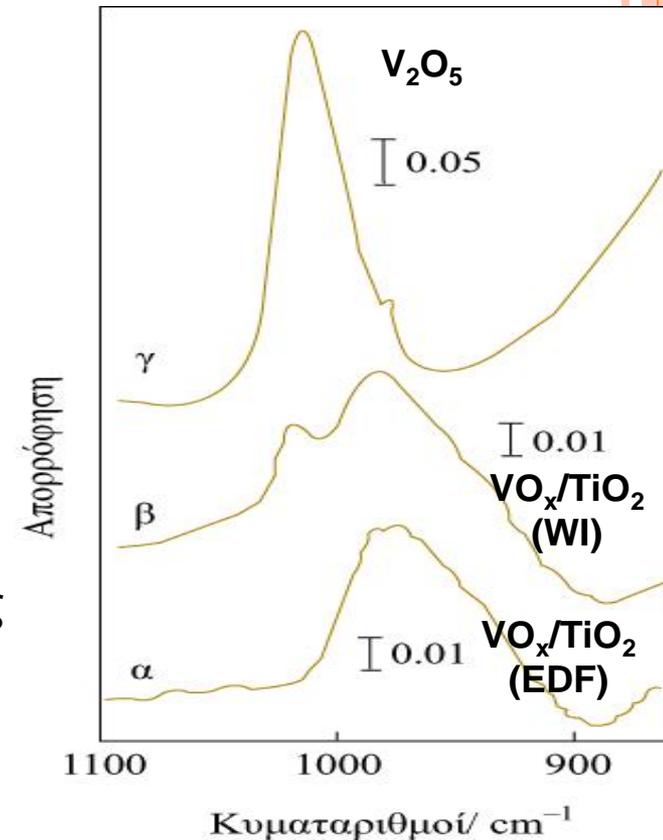
- όχι πολύ ισχυρή απορρόφηση
- μέγεθος σωματιδίων $< \lambda$

Διάχυτη ανάκλαση

- όχι πολύ ισχυρή απορρόφηση

$$F(R_\infty) = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} = \frac{K}{S}$$

R : ανακλαστικότητα
 K : συντελεστής απορρόφησης
 S : συντελεστής σκέδασης



Μέθοδοι προσδιορισμού της δομής των καταλυτικών συστατικών

Φασματοσκοπίες Δόνησης

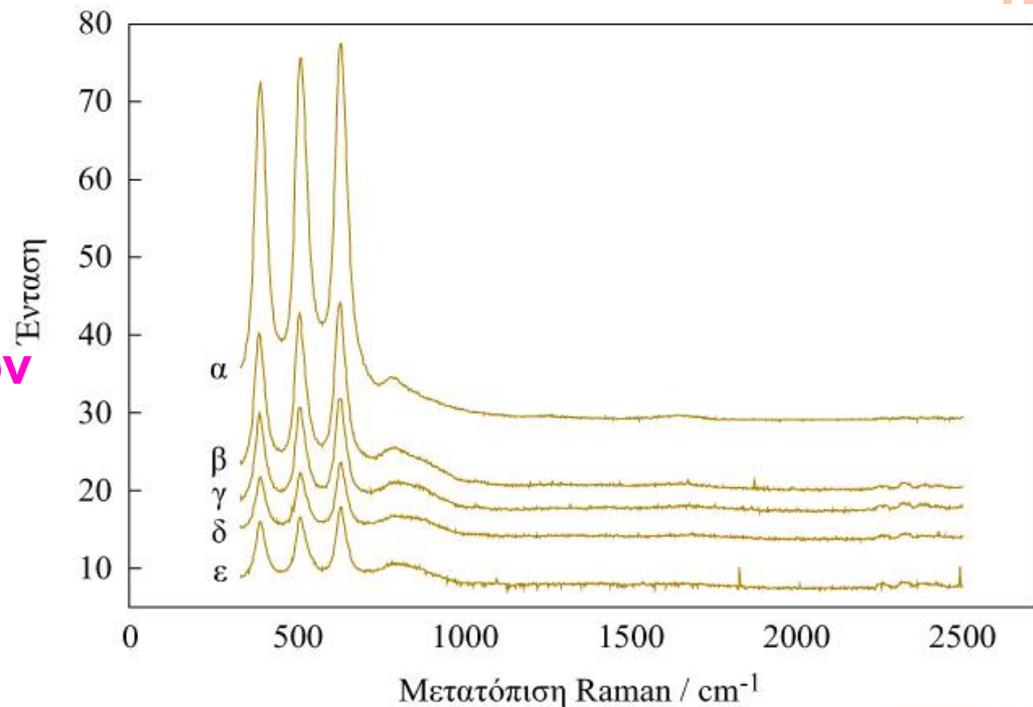
2. Φασματοσκοπία Laser Raman

Πλεονεκτήματα

- Αμελητέες παρεμβολές
- Απλές κυψελίδες
- Αμελητέα συνεισφορά φορέων

Προβλήματα

- Υπερθέρμανση από τη δέσμη
- Χαμηλή ευαισθησία
- Ανύψωση γραμμής βάσης λόγω φθορισμού



CrO_x/TiO₂,

% mol Cr: α=0, β=2, γ=4, δ=6, ε=8

Μέθοδοι προσδιορισμού της δομής των καταλυτικών συστατικών

Φασματοσκοπία υπεριώδους – ορατού και εγγύς υπερύθρου

200-400 nm

400-800 nm

800-2500 nm

Έλεγχος όλης της πορείας σύνθεσης και λειτουργίας του καταλύτη

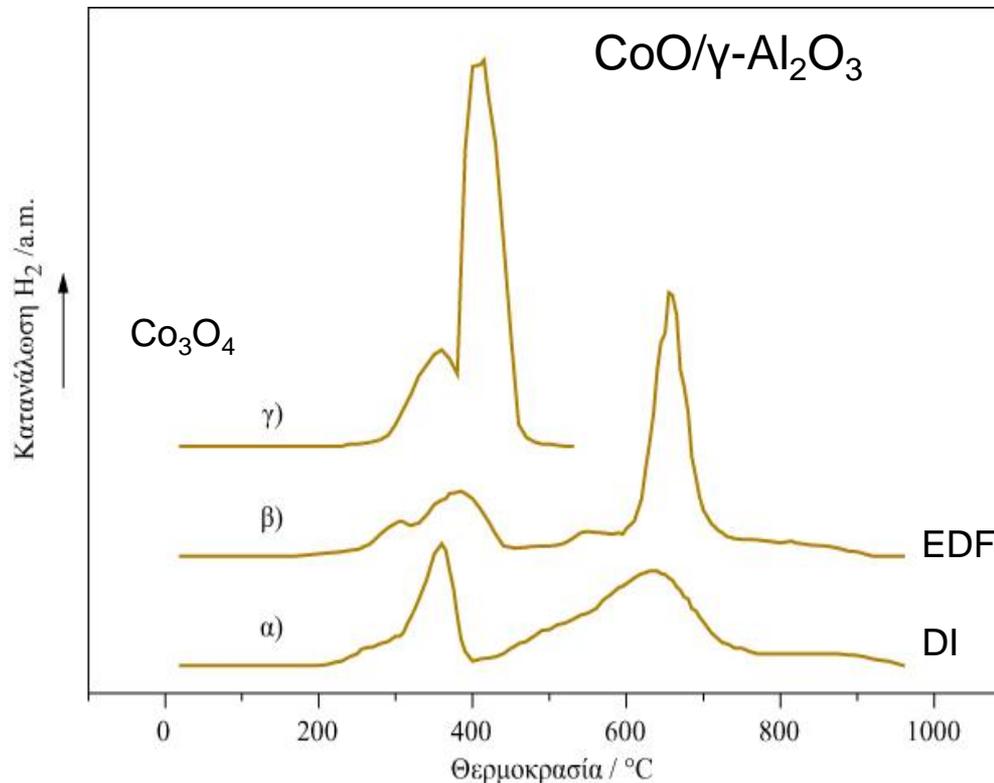
- Διαλύματα πρόδρομων ενώσεων
- Αλληλεπίδραση πρόδρομων ενώσεων με φορέα
- Χημικές αλλαγές πρόδρομων καταλυτικών φάσεων μετά από κάθε στάδιο κατεργασίας
- Τροποποίηση των παραπάνω μετά την επαφή με αντιδρώντα ή/και δηλητήρια
- Φύση προσροφημένων μορίων κατά την αντίδραση



Μέθοδοι προσδιορισμού της δομής των καταλυτικών συστατικών

Μέθοδοι θερμικής ανάλυσης

Θερμοπρογραμματισμένη αναγωγή (TPR)



Μέθοδοι επιφανειακής ανάλυσης

Επιφάνεια: μια απειροελάχιστα λεπτή στοιβάδα που διαχωρίζει δύο φάσεις

Ανάλυση: μελέτη της απόκρισης της επιφάνειας μετά από ακτινοβολία

Διακριτική ικανότητα: ανάλυση μικρότερης δυνατής επιφάνειας

- εξαρτάται από τη φύση και τα χαρακτηριστικά προσπίπτουσας δέσμης

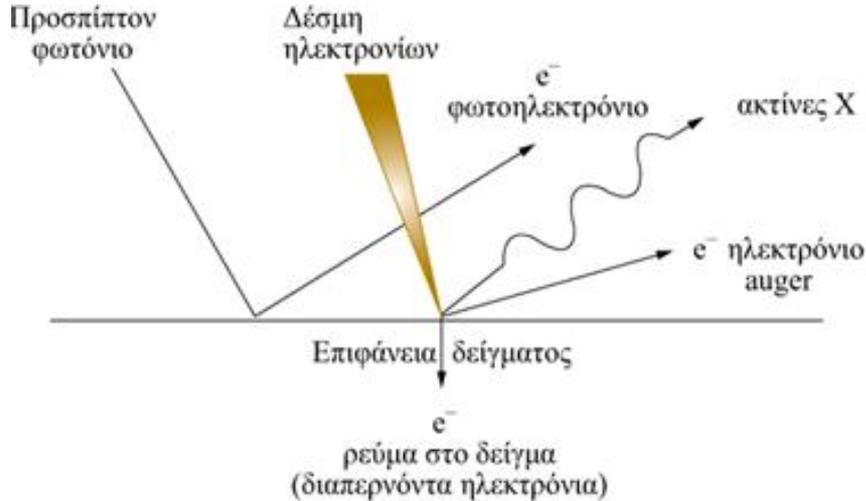
Βάθος ανάλυσης: βάθος απόκρισης επιφάνειας μετά την ακτινοβολία

- εξαρτάται από το είδος της απόκρισης & τα χαρακτηριστικά της προσπίπτουσας δέσμης
- για ηλεκτρόνια καθορίζεται από τη *μη ελαστική μέση ελεύθερη διαδρομή*

Μέθοδοι επιφανειακής ανάλυσης

Διακριτική
ικανότητα

XPS < AES
100 nm



Βάθος
ανάλυσης

XPS ≈ AES
(40 Å)

XPS ή ESCA

Προσπ. δέσμη: Ακτίνες-X

Απόκρ. επιφάνειας:
Ηλεκτρόνια

AES ή SAM

Προσπ. δέσμη:
Ηλεκτρόνια (1-5 keV)

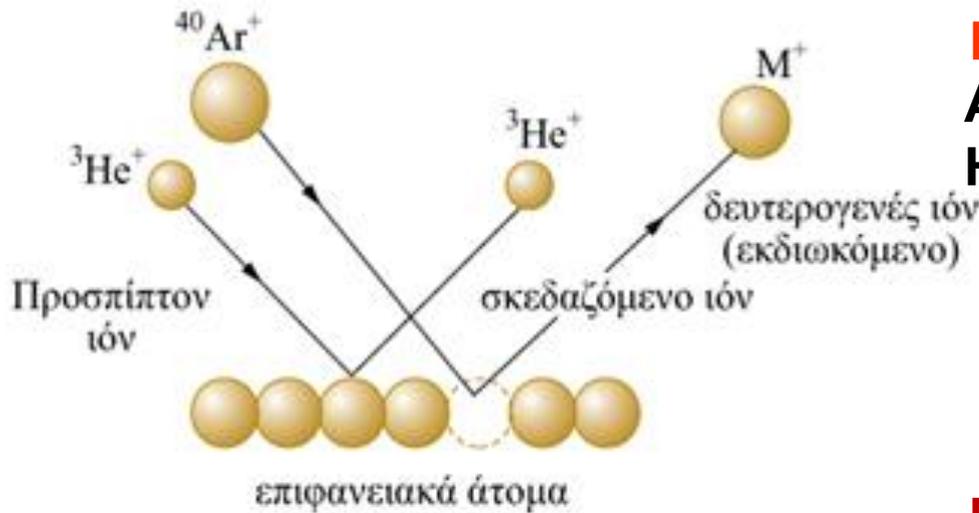
Απόκρ. επιφάνειας:
Ηλεκτρόνια



Μέθοδοι επιφανειακής ανάλυσης

Διακριτική
ικανότητα
ISS < SIMS

Βάθος
ανάλυσης
ISS < SIMS



ISS

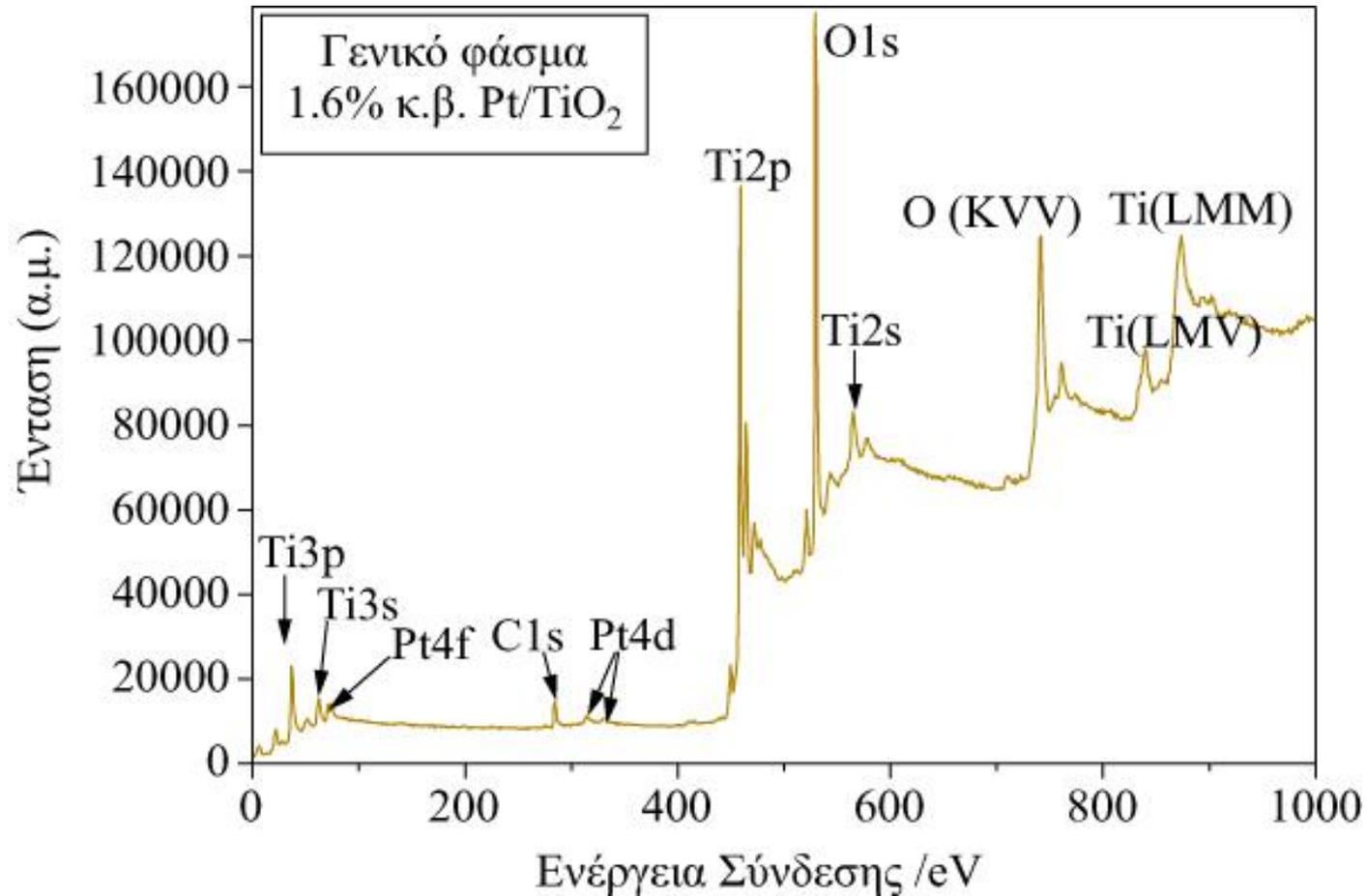
Προσπ. δέσμη:
 He^+ ή Ar^+ (0,5-5 keV)
Απόκρ. επιφάνειας:
 He^+ ή Ar^+

SIMS

Προσπ. δέσμη:
 He^+ ή Ar^+ (1-10 keV)
Απόκρ. επιφάνειας:
Ιονισμένα είδη



Φάσμα φωτοηλεκτρονίων των ακτίνων-Χ



Προσδιορισμός της Οξεο-βασικής Συμπεριφοράς των Επιφανειών

Θερμοπρογραμματισμένη εκρόφηση αμμωνίας (NH_3 - TPD)

125°C:

φυσικά προσροφημένη NH_3

200°C: Όξινες θέσεις Bronsted

280°C: Όξινες θέσεις Lewis

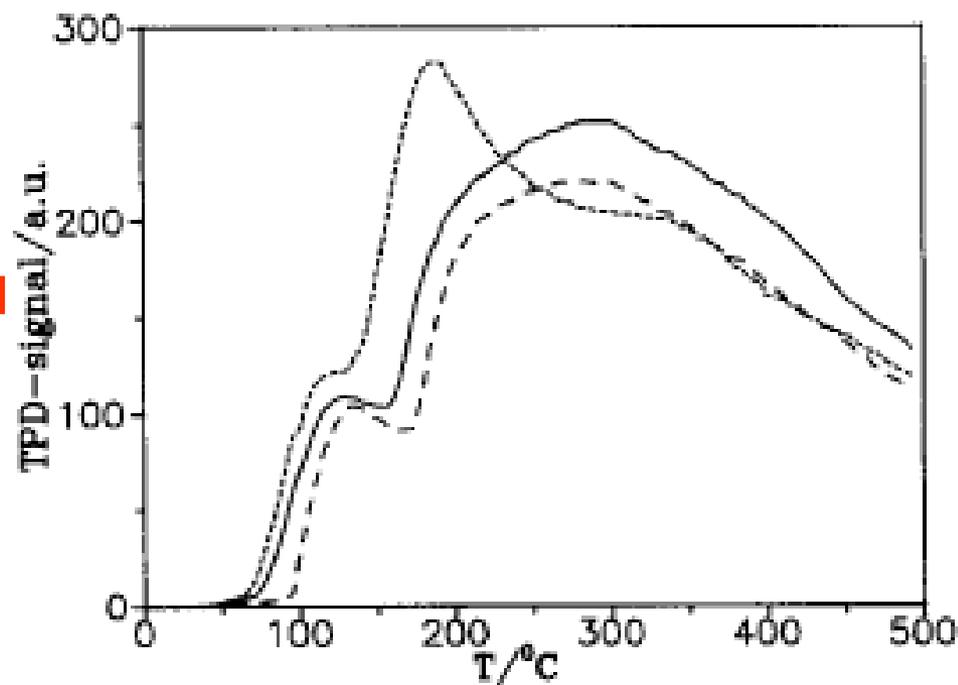


Fig. 4. TPD of ammonia from the surface of the anatases studied. ···, TS; —, TI; ---, TC.

Ευχαριστώ για τη
συμμετοχή σας

Σας εύχομαι καλή
επιτυχία στις Εξετάσεις

